

電気学会研究会資料目次

電子材料 合同研究会 電子デバイス

[委員長] 羽路伸夫 (横浜国立大学)
[幹事] 岡田至崇 (筑波大学), 西川宏之 (芝浦工業大学)
[委員長] 益一哉 (東京工業大学)
[幹事] 荒川太郎 (横浜国立大学), 上野和良 (芝浦工業大学)
大見俊一郎 (東京工業大学)
[幹事補佐] 本間哲哉 (芝浦工業大学)

日時 平成18年11月28日(火) 9:30~17:45

場所 首都大学東京南大沢キャンパス 理・工教室棟2階204号室
(〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1 <http://www.metro-u.ac.jp/access.htm> 参照)

テーマ「半導体パワーデバイス, 材料一般」

- EFM-06-25 MOCVD 選択成長による低オーミックコンタクト形成
EDD-06-100
戸田典彦, 見田充郎, 伊藤正紀,
丸井俊治, 星 真一, 佐野芳明, 関 昇平 (沖電気工業) …… 1
- EFM-06-26 高耐圧 GaN-HEMT における電流コラプスのフィールドプレート構造依存性
EDD-06-101
齋藤 渉, 蔵口雅彦, 高田賢治, 津田邦男,
齋藤泰伸, 野田隆夫, 大村一郎, 山口正一 (東芝) …… 7
- EFM-06-27 高出力 AlGaIn/GaN HFET の電源応用
EDD-06-102
池田成明, 神林 宏, 李 江,
増田 満, 野村剛彦, 吉田清輝 (古河電気工業) …… 11
- EFM-06-28 セルフアラインプロセスにより作製した GaN 系縦型トランジスタ
EDD-06-103
森田竜夫, 中澤敏志, 上田哲三, 田中 毅 (松下電器産業) …… 17

EFM-06-29 EDD-06-104	絶縁ゲート AlGaIn/GaN-HFET の縦型動作	兼近将一 (豊田中央研究所) 杉本雅裕 (トヨタ自動車) 副島成雅, 上田博之, 石黒 修, 樹神雅人, 林 栄子, 上杉 勉, 加地 徹 (豊田中央研究所) ……	21
EFM-06-30 EDD-06-105	シリコンパワー素子の現状	大村一郎 (東芝セミコンダクター社) ……	25
EFM-06-31 EDD-06-106	シリコン・パワートランジスタ開発者の新材料パワーデバイスへの期待	高田育紀 (三菱電機) ……	31
EFM-06-32 EDD-06-107	Si パワーデバイス Super Junction MOSFET 開発 ー トレンチ埋込エピタキシャル成長技術による Si-Limit 突破ー	山内庄一, 柴田 巧, 山口 仁 (デンソー) 野上彰二, 山岡智則 (SUMCO) 服部佳晋 (豊田中央研究所) ……	37
EFM-06-33 EDD-06-108	SiC 結晶成長と欠陥評価	土田秀一 (電力中央研究所) ……	43
EFM-06-34 EDD-06-109	最近の SiC デバイスプロセス技術	福田憲司 (産業技術総合研究所) ……	49
EFM-06-35 EDD-06-110	GaN on Si パワーデバイスの開発動向	後藤博一 (サンケン電気) ……	53
協 賛	次世代ハイパワー応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会 パワーデバイス高性能化・高機能化技術調査専門委員会		